

# ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

между

Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  
Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)

и

Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования  
“Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики  
(технический университет)”

01 ноября 2007 г.

г. Москва

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук, именуемый в дальнейшем ИСВЧПЭ РАН, в лице директора гл.-кор. РАН Мокерова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)”, именуемый в дальнейшем ГОУ ВПО МИРЭА, в лице ректора чл.-кор. РАН Сигова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение о нижеследующем.

## **Статья 1. Предмет Генерального соглашения**

С целью привлечения студентов, аспирантов и молодых специалистов, оканчивающих ГОУ ВПО МИРЭА, к решению конкретных научно-технических задач по тематике ИСВЧПЭ РАН, развития вузовской науки и укрепления связи ее с научными организациями РАН организовать в МИРЭА при кафедре Полупроводниковых приборов факультета Электроники объединенную научно-исследовательскую лабораторию “Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные устройства” (далее по тексту – ОНИЛ) и совместно оборудовать ее необходимыми для работы программными и измерительными средствами.

## **Статья 2. Задачи и статус лаборатории**

2.1. ОНИЛ является структурным подразделением факультета Электроники, организационно входящим в научно-исследовательскую часть МИРЭА. В своей хозяйственной деятельности ОНИЛ руководствуется Уставом МИРЭА и Положением об объединенной научно-исследовательской лаборатории “Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные устройства”, утвержденным ректором МИРЭА и согласованным с директором ИСВЧПЭ РАН.

2.2. ОНИЛ работает по планам, утверждаемым Ректором МИРЭА и согласованным с директором ИСВЧПЭ РАН.

## **Статья 3. Обязательства ИСВЧПЭ РАН**

3.1. Обеспечить сотрудников ОНИЛ работой по профилю ИСВЧПЭ РАН, связанной с моделированием, проектированием и экспериментальным подтверждением результатов проектирования, и финансировать ее в соответствии со статьей 5 настоящего Генерального соглашения.

3.2. В случае отсутствия в МИРЭА необходимого измерительного оборудования предоставлять во временное пользование приборы из своего фонда.

3.3. Силами своих сотрудников организовать начальное обучение сотрудников ОНИЛ методам проектирования в программном пакете Microwave Office и осуществлять регулярный шеф-контроль хода работ.

#### Статья 4. Обязательства ГОУВПО МИРЭА

4.1. Разработать Положение об объединенной научно-исследовательской лаборатории «Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные устройства».

4.2. Обеспечивать прием сотрудников в ОНИЛ из числа выпускников и студентов в количестве, необходимом для эффективного решения поставленных задач.

4.3. Передать ОНИЛ лицензионные программные пакеты приборно-технологического моделирования Synopsis Sentaurus T-CAD и моделирования СВЧ приборов и устройств Microwave Office.

4.4. Предоставить для работы ОНИЛ помещения из числа закрепленных за кафедрой «Полупроводниковые приборы».

#### Статья 5. Условия финансирования

Стороны согласились, что финансирование работ ОНИЛ осуществляется ИСВЧПЭ РАН, в том числе, путем заключения хоздоговоров на период действия настоящего Генерального соглашения.

#### Статья 6. Срок действия Генерального соглашения

Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

#### Статья 7. Дополнительные положения

7.1. Настоящее Генеральное соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из сторон с уведомлением другой стороны о его расторжении не менее чем за 2 месяца до даты расторжения.

7.2. Настоящее Генеральное соглашение считается продленным на следующие 5 лет, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Генерального соглашения.

7.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба из которых имеют одинаковую юридическую силу.



Директор ИСВЧПЭ РАН  
полн.-корреспондент РАН

В.Г. Мокеров

ноября 2007 г.

Согласовано:

Заместитель директора ИСВЧПЭ РАН

Проректор по научной работе МИРЭА

Декан факультета Электроники МИРЭА

Заместитель заведующего кафедрой «Полупроводниковые приборы»



Директор МИРЭА  
полн.-корреспондент РАН

А.С. Сигов

ноября 2007 г.

А.П. Сеничкин

А.И. Морозов

Ю.К. Фетисов

А.А. Зайцев